

(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.³

H01L 21/205

H01L 31/04

(11) 공개번호 특 1984-0005914

(43) 공개일자 1984년 11월 19일

(21) 출원번호 특 1983-0003775

(22) 출원일자 1983년 08월 12일

(30) 우선권주장 407983 1982년 08월 13일 미국(US)

(71) 출원인 에너지 컨버전 디바어시즈, 아이 엔 씩

미합중국, 미시간 48084, 트로이, 웨스트 메이리를 로우드 1675

(72) 발명자 조아킴 도엘러

미합중국, 미시간 48085, 유니온 레이크, 베니스 드라이브 6183

(74) 대리인 목영동

심사청구 : 없음**(54) 흡파인 가스게이트****요약**

내용 없음

대표도**도1****명세서**

[발명의 명칭]

흡파인 가스게이트

[도면의 간단한 설명]

제1도는 다수의 p-i-n 형전지들로 구성되어 있고, 전지의 각층이 본 발명의 원칙들에 따라 비결정성 반도체합금으로 형성되어 있는 탠덤 또는 캐스케이드 광전지장치의 단편적 단면도.

제2도는 제1도에 표시된 광전지장치를 연속적으로 생산할 수 있게 되어있는 각 용착체임버 속으로 도입된 가스성분을 실질적으로 격리시키는 가스게이트가 포함된 다중글로우방전체임비용착시스템의 도식적 도면.

제3도는 자기가스게이트어셈블리의 상부 블록내에 형성된 리세스 안에서의 자석과 분리기들의 배열을 도해한 단면도.

제4도는 본 발명의 기본원칙들에 따라 가스게이트의 상부 블록내에 형성된 흡유동통에 관계되는 자기 요소들의 배치를 도해한 제2도의 선 4-4에 따라 적당한 단면의 확대도.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용은 수록하지 않았음

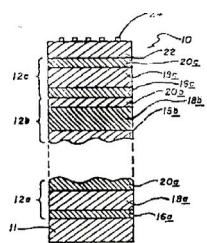
(57) 청구의 범위**청구항 1**

인접한 응착체임버들을 상호 연동적으로 연결하고 그 체임버들 사이의 확산을 상당히 감소시키도록 만 들어진 비교적 좁은 통로, 하나의 반도체층이 섬스트레이트 물질의 한 표면에 우착되도록 되어진 상기 체임버들 중의 하나로 부터 또 하나의 반도체층이 상기 층위에 용착되도록 되어진 인접한 체임버로 섬스트레이트 물질을 통과시키는 수단 및 섬스트레이트의 비성층면을 통로벽을 향해 압착시키는 수단을 포함하고 있는 가스게이트에 있어서, 유동 통로수단(86)은 섬스트레이트의 비성층 표면이 압착되는 통로벽(43a)에 형성되고, 그 유동통로수단은 인접한 체임버(28,30,32)를 상호 연동적으로 연결하여서 흡수단이 형성되어 있는 가스게이트 통로벽과 섬스트레이트 물질의 비성층 표면사이의 공간에 의해 형성되는 통로 슬릿(82)을 통해 가스유동이 이루어지도록 통로(43)와 같은 길이로 연장되며, 상기 가스 유동은 상기 첫번째 체임버(28,32)로부터 부번째 체임버 (32)로의 확산을 상당히 감소시키는 개선된 특징을 갖는 가스게이트.

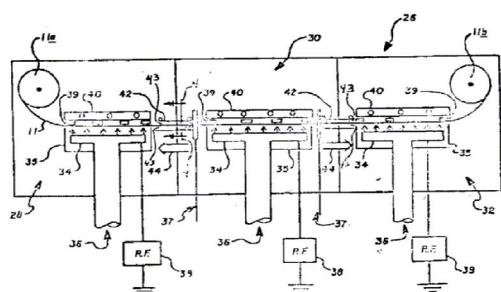
* 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도연

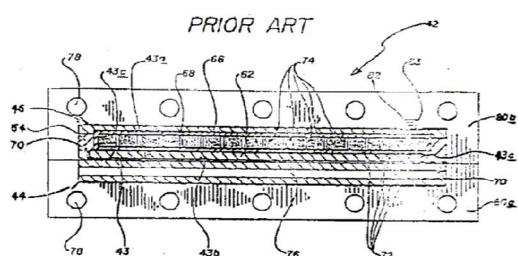
도면1



도면2



도면3



도면4

